

Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, sob responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador.

São Paulo, de dezembro de 2008.

Assinatura do autor _____

Assinatura do orientador _____

FICHA CATALOGRÁFICA

Agopian, Paula Ghedini Der

Estudo do efeito de elevação atípica da transcondutância na região linear de polarização em dispositivos SOI NMOSFETS ultra-submicrométricos / P.G.D. Agopian. -- ed.rev. -- São Paulo, 2008.

147 p.

Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos.

1.Circuitos integrados MOS 2.Microeletrônica I.Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos II.t.